# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-169567

(43)公開日 平成7年(1995)7月4日

(51) IntCL\*

庁内整理番号 識別記号

FΙ

技術表示箇所

H05B 33/04

# 審査請求 未請求 請求項の数22 FD (全 19 頁)

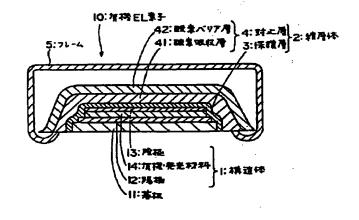
(21)出顧番号	特顧平5-343635	(71)出題人 000183646
(22)出顧日	平成5年(1993)12月16日	出光興産株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号
		(72)発明者 東海林 弘 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株 式会社内
		(72)発明者 弘中 義雄 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株 式会社内
		(72)発明者 松浦 正英 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株 式会社内
		(74)代理人 弁理士 渡辺 喜平 (外1名) 最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 有機EL素子

#### (57)【要約】

【目的】 酸素や水分による発光特性の劣化を防止し て、長期に亘って安定な発光特性が維持され、長寿命の 有機EL素子を提供する。

【構成】 陽極12,有機発光材料14および陰極13 からなる構造体1の外側に積層体2として、保護層3並 びにその外側に酸素吸収層41および酸素バリア層42 からなる封止層4を積層する。



# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 その少なくとも一方が透明または半透明の互いに対向する一対の電極間に、有機発光材料を挟持してなる構造体、並びに、その構造体の外側に配設した保護層および/または封止層からなる積層体を有する有機EL素子において、

前記積層体の封止層が、酸素バリアー層および酸素吸収 層からなる二重層の組を、一組以上有するものであるこ とを特徴とする有機EL素子。

【請求項2】 前記酸素バリアー層および酸素吸収層か 10 らなる二重層の組が前記互いに対向する一対の電極のう ち陰極側の電極側に、酸素吸収層および酸素バリアー層 をこの順に積層したものであることを特徴とする請求項 1 記載の有機EL素子。

【請求項3】 前記構造体が、基板、陽極、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層、陰極、保護層および封止層をこの順に有するものであり、かつ、その封止層が、酸素吸収層及び酸素バリアー層をこの順に有する二重層の一組を、一組以上有するものであることを特徴とする請求項1記載の有機EL素子。

【請求項4】 その少なくとも一方が透明または半透明の互いに対向する一対の電極間に有機発光材料を挟持してなる構造体、並びにその構造体の外側に配設した保護層および/または封止層からなる積層体を有する有機EL素子において、

前記積層体の保護層および封止層の少なくとも一方が、 酸素を吸着、吸蔵又は消費する材料を含有するものであ ることを特徴とする有機EL素子。

【請求項5】 前記積層体の保護層が、酸素を吸着、吸蔵又は消費する材料を含有するものである請求項1~3のいずれか1項記載の有機EL素子。

【請求項6】 前記酸素を吸着、吸蔵又は消費する材料が、酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化鉄、酸化チタン、ベントナイト、酸性白土、モンモリロナイト、ケイソウ土(粘土鉱物)、活性アルミナ、シリカアルミナ、ゼオライト、シリカ、ジルコニア及び活性炭からなる群から選ばれる一以上の物質からなるものであることを特徴とする請求項4または5記載の有機EL素子。

【請求項7】 前記酸素を吸着、吸蔵又は消費する材料が、周期律表第四周期の金属の微粉末、薄膜、その金属塩もしくはその酸化物、または周期律表第四周期の金属の微粉末、薄膜、その金属塩もしくはその酸化物を酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化鉄、酸化チタン、ベントナイト、酸性白土、モンモリロナイト、ケイソウ土(粘土鉱物)、活性アルミナ、シリカアルミナ、ゼオライト、シリカ、ジルコニア及び活性炭からなる群から選ばれる一以上の物質に10重量%以下の濃度で担持させたものであることを特徴とする請求項4または5記載の有機EL素子。

【請求項8】 前記周期律表第四周期の金属がFe, Co, Ni, Mn, Cr, V, ZnもしくはCuの単体又はそれらの一種以上の合金であることを特徴とする請求項7記載の有機EL素子。

2

【請求項9】 前記周期律表第四周期の金属の合金が酸化コバルト(II)であることを特徴とする請求項8記載の有機EL素子。

【請求項10】 前記酸素を吸着、吸蔵又は消費する材料が、炭素数が3~30の、一級または二級の炭素を持0つ炭化水素を、周期律表第四周期の金属の微粉末、薄膜、その金属塩もしくはその酸化物、または周期律表第四周期の金属の微粉末、薄膜、その金属塩もしくはその酸化物を酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化鉄、酸化チタン、ベントナイト、酸性白土、モンモリロナイト、ケイソウ土(粘土鉱物)、活性アルミナ、シリカアルミナ、ゼオライト、シリカ、ジルコニア及び活性炭からなる群から選ばれる一以上の物質に10重量%以下の濃度で担持させたもの、または活性炭に1重量%以下の濃度で担持させたものであることを特徴とする請求20項4または5記載の有機EL素子。

【請求項11】 前記酸素を吸着、吸蔵又は消費する材料が、白金、パラジウム、ロジウム、ルテニウム又は銀を、酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化鉄、酸化チタン、ベントナイト、酸性白土、モンモリロナイト、ケイソウ土(粘土鉱物)、活性アルミナ、シリカアルミナ、ゼオライト、シリカ、ジルコニア及び活性炭からなる群から選ばれる一以上の物質に5重量%以下の濃度で担持させたものであることを特徴とする請求項4または5記載の有機EL素子。

【請求項12】 その少なくとも一方が、透明または半透明の互いに対向する一対の電極間に有機発光材料を挟持してなる構造体、並びにその構造体の外側に配設した保護層および/または封止層からなる積層体を有する有機EL素子において、

前記積層体の保護層が脱水剤を含有するものであること を特徴とする有機EL素子。

【請求項13】 前記積層体の保護層が脱水剤を含有するものであることを特徴とする請求項1~11のいずれか1項記載の有機EL素子。

【請求項14】 前記積層体の保護層が固体の有機物であることを特徴とする請求項12または13記載の有機 EL素子。

【請求項15】 前記脱水剤が、アルカリ金属またはアルカリ土類金属からなるものであることを特徴とする請求項12~14のいずれか1項記載の有機EL素子。

【請求項16】 その少なくとも一方が透明または半透明の互いに対向する一対の電極の間に有機発光材料を挟持してなる構造体、並びにその構造体の外側に配設した保護圏および/または封止層からなる積層体を有する行
50 機EL素子において、前記積層体の封止層が、無機組成

物を含有する光または熱硬化性樹脂からなるものである ことを特徴とする有機EL素子。

【請求項17】 前記積層体の封止層が、無機組成物を含有する光または熱硬化性樹脂からなるものであることを特徴とする請求項1~15のいずれか1項記載の有機EL素子。

【請求項18】 前記無機組成物がシリカガラスであることを特徴とする請求項16または17記載の有機EL素子。

【請求項19】 その少なくとも一方が透明または半透 10 明の互いに対向する一対の電極の間に有機発光材料を挟持してなる構造体、並びにその構造体の外側に配設した保護層および/または封止層からなる積層体を有する有機EL素子において前記積層体の保護層および封止層の少なくとも一方が、酸素透過係数が1×10<sup>-12</sup> c c・c m/c m<sup>2</sup>·S (c m H g) 以下である有機層を少なくとも一層有するものであることを特徴とする有機EL素子。

【請求項22】 前記積層体の封止層の外側に、さらに 酸素透過係数が $1 \times 10^{-12}$  c c · c m / c c mHg) 以下である有機層を少なくとも一層有すること を特徴とする請求項 $1 \sim 18$ のいずれか1 項記載の有機 E L 素子。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、有機EL(電界発光) 素子に関する。さらに詳しくは、主に、情報産業機器用 の各種ディスプレーや発光素子に好適に用いられる、長 期に亘って安定な発光特性が維持され、長寿命の有機E L素子に関する。

[0002]

【従来の技術】有機EL素子は、有機発光材料を一対の対向電極で挟んだ構造体で構成されており、一方の電極からは電子が注入され、他方の電極からは正孔が注入される。この注入された電子と正孔とが、発光層内で再結合するときに発光が生ずる。この有機EL素子は、その耐衝撃性や視認性の高さと、有機物の持つ発光色の多様性からフルカラーのフラットパネルディスプレーとして、またはLEDに代わるものとして期待され開発が進められている。

【0003】 このような有機 E L 素子は、連続または不 50

連続に一定期間駆動した場合、発光輝度、発光効率および発光の均一性等の発光特性が初期の場合に比べ著しく低下することが知られている。このような発光特性の劣化の原因としては、有機EL素子内に侵入した酸素による電極の酸化、駆動時の発熱による有機材料の酸化分解、また、有機EL素子内に侵入した空気中に水分による電極の酸化、有機物の変性等を挙げることができる。さらに酸素や水分の影響で構造体の界面が剥離したり、駆動時の発熱や駆動時の環境が高温であったこと等が引き金となって、各構成要素の熱膨張率の違いにより構造体の界面で応力が発生し、界面が剥離する等の構造体の機械的劣化をその原因として挙げることができる。

【0004】このような発光特性の劣化を防止する発明 として、①有機EL素子の積層構造体の外表面に電気絶 縁性無機化合物からなる保護膜を設け、この保護層の外 側に、電気絶縁性ガラス、エポキシ樹脂、シリコーン樹 脂等の電気絶縁性高分子化合物および電気絶縁性気密流 体からなる群から選択される物質からなるシールド層を 設けた封止方法(特開平5-89959号公報)、②背 面基板および水分吸収体を有する固体状またはゲル状の 絶縁性材料により薄膜EL素子が封止されてなる薄膜E Lパネル (特開平2-12792号公報)、③EL素子 を箱詰めにして、その中に五酸化二リンをEL素子に触 れないように共有させる方法(特開平3-261091 号公報)、および④EL素子をフルオロカーボン油に沈 め、そのフルオロカーボン油中に脱水剤を混ぜ、水分を 除く方法 (特開平5-41281号、及び114486 号公報)、および⑤光硬化性樹脂を用いた、気密性が高 く耐湿性のある封止技術(特開平5-182759号公 報) 等が開示されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前記①の封止 方法では、酸素についての封止の効果が必ずしも十分に 満足できるものではなく、②の薄膜ELパネルでは、や はり酸素についての封止の効果が不十分であり、③の方 法では、EL素子を箱詰めにし、その中に五酸化二リン の入った別の容器を作らなければならないので素子の作 製が煩雑であり、また五酸化二リンはEL素子の電極や 有機物と激しく反応するため、耐衝撃性を考慮しなけれ 40 ばならないので、実用的ではなく、①の方法では、フル オロカーボン油は液体であるため、封止の際取扱いが困 難であり、また、破壊の際に液漏れの危険があるため実 用的ではなく、また、⑤の方法では、このような樹脂の 硬化時の収縮や、EL素子と封止層との膨張率の違い (温度サイクル) により、素子が機械的に劣化、延いて は破壊するという問題があった。本発明は上述の問題に 鑑みなされたもので、酸素や水分による発光特性の劣化 を防止して、長期に亘って安定な発光特性が維持され、 長寿命の有機EL素子を提供することを目的とする。ま

た、温度サイクルによる索子の機械的劣化を防止して、

5

長期に亘って安定な発光特性が維持され、長寿命の有機 E L 素子を提供することを他の目的とする。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明によれば、その少なくとも一方が透明または半透明の互いに対向する一対の電極間に、有機発光材料を挟持してなる構造体、並びに、その構造体の外側に配設した保護層および/または封止層からなる積層体を有する有機EL素子において、前記積層体の封止層が、酸素バリアー層および酸素吸収層からなる二重層の組を、一組以上有するものであることを特徴とする有機EL素子が提供される。

【0007】また、前記酸素バリアー層および酸素吸収層からなる二重層の組が前記互いに対向する一対の電極のうち陰極側の電極側に、酸素吸収層および酸素バリアー層をこの順に積層したものであることを特徴とする有機EL素子が提供される。

【0008】また、前記構造体が、基板、陽極、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層、陰極、保護層および封止層をこの順に有するものであり、かつ、その封止 20層が、酸素吸収層及び酸素バリアー層をこの順に有する二重層の一組を、一組以上有するものであることを特徴とする有機EL素子が提供される。

【0009】また、その少なくとも一方が透明または半透明の互いに対向する一対の電極間に有機発光材料を挟持してなる構造体、並びにその構造体の外側に配設した保護層および/または封止層からなる積層体を有する有機EL素子において、前記積層体の保護層および封止層の少なくとも一方が、酸素を吸着、吸蔵又は消費する材料を含有するものであることを特徴とする有機EL素子30が提供される。

【0010】また、前記積層体の保護層が、酸素を吸着、吸蔵又は消費する材料を含有するものである有機E L素子が提供される。

【0011】また、前記酸素を吸着、吸蔵又は消費する材料が、酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化鉄、酸化チタン、ベントナイト、酸性白土、モンモリロナイト、ケイソウ土(粘土鉱物)、活性アルミナ、シリカアルミナ、ゼオライト、シリカ、ジルコニア及び活性炭からなる群から選ばれる一以上の物質からなるものであることを特徴とする有機EL素子が提供される。

【0012】また、前記酸素を吸着、吸蔵又は消費する材料が、周期律表第四周期の金属の微粉末、薄膜、その金属塩もしくはその酸化物、または周期律表第四周期の金属の微粉末、薄膜、その金属塩もしくはその酸化物を酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化鉄、酸化チタン、ベントナイト、酸性白土、モンモリロナイト、ケイソウ土(粘土鉱物)、活性アルミナ、シリカアルミナ、ゼオライト、シリカ、ジルコニア及び活性炭からなる群から選ばれる一以上の物質に10重量%以下の濃度 50

で担持させたものであることを特徴とする有機EL素子 が提供される。

【0013】また、前記周期律表第四周期の金属がFe, Co, Ni, Mn, Cr, V, ZnもしくはCuの単体又はそれらの一種以上の合金であることを特徴とする有機EL素子が提供される。

【0014】また、前記周期律表第四周期の金属の合金が酸化コバルト(II)であることを特徴とする有機EL 素子が提供される。

【0015】また、前記酸素を吸着、吸蔵又は消費する材料が、炭素数が3~30の、一級または二級の炭素を持つ炭化水素を、周期律表第四周期の金属の微粉末、薄膜、その金属塩もしくはその酸化物、または周期律表第四周期の金属の微粉末、薄膜、その金属塩もしくはその酸化物を酸化マグネシウム,炭酸マグネシウム,酸化鉄,酸化チタン,ベントナイト,酸性白土,モンモリロナイト,ケイソウ土(粘土鉱物),活性アルミナ,シリカアルミナ,ゼオライト,シリカ,ジルコニア及び活性炭からなる群から選ばれる一以上の物質に10重量%以下の濃度で担持させたもの、または活性炭に1重量%以下の濃度で担持させたものであることを特徴とする有機EL素子が提供される。

【0016】また、前記酸素を吸着、吸蔵又は消費する材料が、白金、パラジウム、ロジウム、ルテニウム又は銀を、酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化鉄、酸化チタン、ベントナイト、酸性白土、モンモリロナイト、ケイソウ土(粘土鉱物)、活性アルミナ、シリカアルミナ、ゼオライト、シリカ、ジルコニア及び活性炭がらなる群から選ばれる一以上の物質に5重量%以下の過度で担持させたものであることを特徴とする有機EL素子が提供される。

【0017】また、その少なくとも一方が、透明または 半透明の互いに対向する一対の電極間に有機発光材料を 挟持してなる構造体、並びにその構造体の外側に配設し た保護層および/または封止層からなる積層体を有する 有機EL素子において、前記積層体の保護層が脱水剤を 含有するものであることを特徴とする有機EL素子が提 供される。

【0018】また、前記積層体の保護層が脱水剤を含有 40 するものであることを特徴とする有機EL素子が提供さ れる。

【0019】また、前記積層体の保護層が固体の有機物であることを特徴とする有機EL素子が提供される。

【0020】また、前記脱水剤が、アルカリ金属またはアルカリ土類金属からなるものであることを特徴とする有機EL素子が提供される。

【0021】また、その少なくとも一方が透明または半透明の互いに対向する一対の電極の間に有機発光材料を 挟持してなる構造体、並びにその構造体の外側に配設し た保護層および/または封止層からなる積層体を有する

,

有機EL素子において、前記積層体の封止層が、無機組成物を含有する光または熱硬化性樹脂からなるものであることを特徴とする有機EL素子が提供される。

【0022】また、前記積層体の封止層が、無機組成物 を含有する光または熱硬化性樹脂からなるものであるこ とを特徴とする有機EL素子が提供される。

【0023】また、前記無機組成物がシリカガラスであることを特徴とする有機EL素子が提供される。

【0024】また、その少なくとも一方が透明または半透明の互いに対向する一対の電極の間に有機発光材料を 10 挟持してなる構造体、並びにその構造体の外側に配設した保護層および/または封止層からなる積層体を有する有機EL素子において前記積層体の保護層および封止層の少なくとも一方が、酸素透過係数が1×10<sup>-12</sup> c c・c m/c m²・S (c m H g)以下である有機層を少なくとも一層有するものであることを特徴とする有機EL素子が提供される。

【0025】また、前記積層体の保護層が、酸素透過係数が $1 \times 10^{-12}$  c c · c m / c m  $^2$  · S (c m H g)以下である有機層を少なくとも一層有するものであること 20を特徴とする有機E L 素子が提供される。

【0026】また、前記積層体の封止層が、酸素透過係数が $1 \times 10^{-12}$  c c · c m/c m<sup>2</sup> · S (c mHg)以下である有機層を少なくとも一層有するものであることを特徴とする有機EL素子が提供される。

【0027】さらに、前記積層体の封止層の外側に、さらに酸素透過係数が $1\times10^{-12}$  c c · c m/c m<sup>2</sup>·S (c m H g)以下である有機層を少なくとも一層有することを特徴とする有機E L 素子が提供される。

【0028】以下、本発明に用いられる有機EL素子の 構成を説明する。まず、本発明に用いられる有機EL素 子の構造体について説明する。その構成は、特に限定さ れるものではなく任意の構成を採ることができる。たと えば、陽極/発光層/陰極、陽極/正孔注入層/発光層 /陰極、陽極/発光層/電子注入層/陰極、又は陽極/ 正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極を挙げることが できる。また各層が複数の層の積層体でもよいし、複数 の材料の混合層でもよい。これらの有機物各層はたとえ ば特願平5-028659号に提案された有機物を入れ たボート、フィラメント等により抵抗加熱方式にて加熱 して蒸発させ、かつ、その蒸発させた有機物を一方の電 極上に堆積させて有機物層を形成する方法を用いて形成 することができる。各層の厚さは特に限定されるもので はない。陰陽の電極を除いた各層の厚さは通常5nm~ 5μmである。また材料は通常有機EL素子に使われる ものなら特に限定されない。以下、具体的に、陽極/正 孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極からなる 有機EL素子の構造体について説明する。

## 【0029】 ① 基板

本発明に用いられる有機EL素子の構造体は、基板上に 50 げることができる。その代表例としては

て形成することが好ましい。本発明に用いられる基板は、透明性を有するものが好ましく、具体的にはガラス,透明プラスチック,石英などを挙げることができ

## 【0030】②電極

本発明に用いられる電極は、その少なくとも一方が透明 または半透明の互いに対向する一対の電極(陽極及び陰 極)からなる、透明または半透明とするのは透明性を得 るためである。

#### 0 22-1 陽極

#### 【0031】②-2 陰極

一方、陰極としては、仕事関数の小さい(4 e V以下)金属,合金,電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものを用いることができる。このような電極物質の具体例としては、ナトリウム,ナトリウムーカリウム合金,マグネシウム,リチウム,マグネシウム,リチウム,ネグロム,不力の上海混合物,A 1 / (A 1 2 O 3 ),インジウム,希土電極物質を蒸着やスパッタリングなどの方法により、海底などを挙げることができる。該陰極は、これらの腹を形成させることにより、作成することができる。また、電極としてのシート抵抗は数百Ω/ロ以下とするとが好ましく、膜厚は通常10nm~1μm,好まことが好ましく、膜厚は通常10nm~1μm,好まことが好ましく、に表子においては、該陽極又は陰極のいず光を透明又は半透明とすることが、電極自体が発光を透過して、発光の取り出し効率を向上させるため好ましい。

#### 【0032】3 発光層

発光層の材料として使用可能な有機化合物としては、特に限定はないが、ベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系、ベンゾオキサゾール系等の蛍光増白剤、金属キレート化オキシノイド化合物、スチリルベンゼン系化合物等を挙げることができる。

【0033】 具体的に化合物名を示せば、例えば、特問 昭59-194393号公報に開示されているものを挙 げることができる。その代表例としては

2, 5-ピス (5, 7-ジーt-ペンチルー2-ベンゾ オキサゾリル)-1, 3, 4-チアジアゾール、4, 4' ービス (5, 7-t-ペンチルー2-ベンソオキサ ゾリル)スチルベン、4,4′ービス[5,7-ジー (2-メチル-2-ブチル)-2-ベンゾオキサゾリ ル] スチルベン、2, 5-ビス (5, 7-ジーtーペン チルー2ーベンゾオキサゾリル)チオフェン、2,5-ビス [5-α, α-ジメチルペンジル-2-ペンソオキ サゾリル] チオフェン、2, 5ービス [5, 7ージー (2-メチル-2-ブチル)-2-ベンゾオキサゾリ ル] -3, 4ジオフェニルチオフェン、2, 5ービス (5ーメチルー2ーベンゾオキサゾリル) チオフェン、 4, 4'-ビス(2-ベンゾオキサゾリル)ビフェニ ル、5-メチル-2-[2-[4-(5-メチル-2-ベンゾオキサゾリル) フェニル] ビニル] ベンゾオキサ ゾール、2-[2-(4-クロロフェニル)ビニル]ナ フト [1, 2-d] オキサゾール等のベンゾオキサゾー ル系、2-2'-(p-フェニレンジビニレン)ービス ベンゾチアゾール等のベンゾチアゾール系、2-[2-[4-(2-ベンゾイミダゾリル) フェニル] ビニル] ベンゾイミダゾール、2-[2-(4-カルボキシフェ ニル) ビニル] ベンゾイミダゾール等のベンゾイミダゾ ール系等の蛍光増白剤を挙げることができる。さらに、 他の有用な化合物は、ケミストリー・オブ・シンセティ ック・ダイズ1971,628~637頁および640 頁に列挙されている。

【0034】前記キレート化オキシノイド化合物としては、例えば特開昭63-295695号公報に開示されているものを用いることができる。その代表例としては、トリス(8-キノリノール)アルミニウム、ビス(8-キノリノール) 亜鉛、ビス(2-メチルー8-キノリノール) アルミニウムオキシド、トリス(8-キノリノール) インジウム、トリス(5-メチルー8-キノリノール) アルミニウム、8-キノリノールリチウム、トリス(5-クロロー8-キノリノール)ガリウム、ビス(5-クロロー8-キノリノール)ガリウム、ビス(5-クロロー8-キノリノール)カルシウム、ポリ[亜鉛(II)ービス(8-ヒドロキシー5ーキノリノニル)メタン]等の8-ヒドロキシキノリン系金属錯体やジリチウムエピントリジオン等を挙げること 40ができる。

メチルスチリル) -2-メチルベンゼン、1, 4-ビス (2-メチルスチリル) -2-エチルベンゼン等を挙げることができる。

【0036】また、特開平2-252793号公報に開示されているジスチリルピラジン誘導体も発光層の材料として用いることができる。その代表例としては、2、5-ビス(4-メチルスチリル)ピラジン、2、5-ビス(4-エチルスチリル)ピラジン、2、5-ビス(4-メトキシスチリル)ピラジン、2、5-ビス(4-メトキシスチリル)ピラジン、2、5-ビス[2-(4-ビフェニル)ビニル]ピラジン、2、5-ビス[2-(1-ビレニル)ビニル]ピラジン、等を挙げることができる。その他のものとして、例えば欧州特許第0387715号明細書に開示されているポリフェニル系化合物も発光層の材料として用いることもできる。

【0037】さらに、上述した蛍光増白剤、金属キレー ト化オキシノイド化合物、およびスチリルベンゼン系化 合物等以外に、例えば12-フタロペリノン(J. Appl. Phys., 第27卷, L713 (1988年))、1, 4 ージフェニルー1, 3ープタジエン、1, 1, 4, 4-テトラフェニルー1, 3ブタジエン(以上Appl. Phys. Lett.,第56巻, L799 (1990年))、ナフタル イミド誘導体(特開平2-305886号公報)、ペリ レン誘導体(特開平2-189890号公報)、オキサ ジアゾール誘導体(特開平2-216791号公報、ま たは第38回応用物理学関係連合講演会で浜田らによっ て開示されたオキサジアゾール誘導体)、アルダジン誘 導体(特開平2-220393号公報)、ピラジリン誘 導体 (特開平2-220394号公報) 、シクロペンダ ジエン誘導体(特開平2-289675号公報)、ピロ 30 ロピロール誘導体(特開平2-296891号公報)、 スチリルアミン誘導体 (Appl. Phys. Lett.,第56巻, L799(1990年))、クマリン系化合物(特開平 2-191694号公報)、国際公開公報WO90/1 3 1 4 8 ♥Appl. Phys. Lett.,vol 58,18,P1982(1991) に記載されているような高分子化合物等も、発光層の材 料として用いることができる。

【0038】本発明では、特に発光層の材料として、芳香族ジメチリディン系化合物(欧州特許第0388768号明細書や特開平3-231970号公報に開示のもの)を用いることが好ましい。具体例としては、1,4-フェニレンジメチリディン、2,5-キシレンジメチリディン、2,5-キシレンジメチリディン、2,6-ナフチレンジメチリディン、1,4-ピフェニレンジメチリディン、1,4-ピフェニレンジメチリディン、9,10-アントラセンジイルジルメチリディン、4,4'-ピス(2,2-ジフェニル)ピフェニル、4,4'-ピス(2,2-ジフェニルビニル)ピフェニル等、およびそれらの誘導体を挙

【0039】このようにして形成される発光層の厚さについては特に限定はなく、状況に応じて適宜選択することができるが、通常5nm~5μmの範囲が好ましい。有機EL素子における発光層は、電界印加時に、陽極または正孔注入層から正孔を注入することができ、かつ陰極または電子注入層から電子を注入することができる注入機能、注入された電荷(電子と正孔)を電界の力で移動させる輸送機能、電子と正孔の再結合の場を提供し、これを発光につなげる発光機能等を有している。なお、正孔の注入されやすさと電子の注入されやすさとの間に 10 は違いがあっても構わない。また、正孔と電子の移動度で表される輸送機能に大小があってもよいが、少なくともどちらか一方を移動させることが好ましい。

#### 【0040】 ④正孔注入層

必要に応じて設けられる正孔注入層の材料としては、従来より光伝導材料の正孔注入材料として慣用されているものや有機EL素子の正孔注入層に使用されている公知のものの中から任意のものを選択して用いることができる。正孔注入層の材料は、正孔の注入、電子の障壁性のいづれかを有するものであり、有機物あるいは無機物のどちらでもよい。

【0041】具体例としては、例えばトリアゾール誘導 体(米国特許3,112,197号明細書等参照)、オ キサジアゾール誘導体(米国特許3,189,447号 明細書等参照)、イミダゾール誘導体(特公昭37-1 6096号公報等参照)、ポリアリールアルカン誘導体 (米国特許3, 615, 402号明細書、同第3, 82 0, 989号明細書、同第3, 542, 544号明細 書、特公昭45-555号公報、同51-10983号 公報、特開昭51-93224号公報、同55-171 05号公報、同56-4148号公報、同55-108 667号公報、同55-156953号公報、同56-36656号公報等参照)、ピラゾリン誘導体およびピ ラゾロン誘導体 (米国特許第3,180,729号明細 書、同第4, 278, 746号明細書、特開昭55-8 8064号公報、同55-88065号公報、同49-105537号公報、同55-51086号公報、同5 6-80051号公報、同56-88141号公報、同 57-45545号公報、同54-112637号公 報、同55-74546号公報等参照)、フェニレンジ 40 アミン誘導体 (米国特許第3, 615, 404号明細 書、特公昭51-10105号公報、同46-3712 号公報、同47-25336号公報、特開昭54-53 435号公報、同54-110536号公報、同54-119925号公報等参照)、アリールアミン誘導体 (米国特許第3, 567, 450号明細書、同第3, 1 80,703号明細書、同第3,240,597号明細 書、同第3,658,520号明細書、同第4,23 2, 103 号明細慧、同第4, 175, 961 号明細 溥、同第4,012,376号明細遺、特公昭49-3

5702号公報、同39-27577号公報、特開昭5 5-144250号公報、同56-119132号公 報、同56-22437号公報、西独特許第1,11 0,518号明細書等参照)、アミノ置換カルコン誘導 体(米国特許第3,526,501号明細書等参照)、 オキサゾール誘導体(米国特許第3, 257, 203号 明細書等に開示のもの)、スチリルアントラセン誘導体 (特開昭56-46234号公報等参照)、フルオレノ ン誘導体(特開昭54-110837号公報等参照)、 ヒドラゾン誘導体(米国特許第3,717,462号明 細書、特開昭54-59143号公報、同55-520 63号公報、同55-52064号公報、同55-46 760号公報、同55-85495号公報、同57-1 1350号公報、同57-148749号公報、特開平 2-311591号公報等参照)、スチルベン誘導体 (特開昭61-210363号公報、同61-2284 51号公報、同61-14642号公報、同61-72 255号公報、同62-47646号公報、同62-3 6674号公報、同62-10652号公報、同62-30255号公報、同60-93445号公報、同60 -94462号公報、同60-174749号公報、同 60-175052号公報等参照)、シラザン誘導体 (米国特許第4, 950, 950号明細書)、ポリシラ ン系(特開平2-204996号公報)、アニリン系共 重合体(特開平2-282263号公報)、特開平1-211399号公報に開示されている導電性高分子オリ ゴマー(特にチオフェンオリゴマー)等を挙げることが できる。

12

【0042】正孔注入層の材料としては上記のものを使用することができるが、ポルフィリン化合物(特開昭63-2956965号公報等に開示のもの)、芳香族第三級アミン化合物およびスチリルアミン化合物(米国特許第4,127,412号明細書、特開昭53-27033号公報、同54-58445号公報、同54-149634号公報、同54-64299号公報、同55-79450号公報、同55-144250号公報、同56-119132号公報、同61-295558号公報、同61-98353号公報、同63-295695号公報等参照)、特に芳香族第三級アミン化合物を用いることが好ましい。

【0043】上記ポルフィリン化合物の代表例としては、ポルフィン、1,10,15,20ーテトラフェニルー21H,23Hーポルフィン銅(II)、1,10,15,20ーテトラフェニルー21H,23Hーポルフィン亜鉛(II)、5,10,15,20ーテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ー21H,23Hーポルフィン、シリコンフタロシアニンオキシド、アルミニウムフタロシアニンクロリド、フタロシアニン(無金属)、ジリチウムフタロシアニン、銅テトラメチルフタロシア50 ニン、銅フタロシアニン、クロムフタロシアニン、亜鉛

フタロシアニン、鉛フタロシアニン、チタニウムフタロ シアニンオキシド、Mgフタロシアニン、銅オクタメチ

13

ルフタロシアニン等を挙げることができる。 【0044】また、前記芳香族第三級アミン化合物およ びスチリルアミン化合物の代表例としては、N, N, N' , N'  $- \mathcal{F} \setminus \mathcal{F} \cup \mathcal{F} \cup$ ニル、N, N' ージフェニルーN, N' ーピスー(3 ー メチルフェニル)-[1,1'-ビフェニル]-4, 4' ージアミン、2, 2ービス(4ージーpートリルア ミノフェニル) プロパン、1,1-ビス(4-ジ-p- 10 トリルアミノフェニル) シクロヘキサン、N, N, N' , N' -f -f -p -h -h -h -hフェニル、1,1-ビス(4-ジ-p-トリルアミノフ ェニル)-4-フェニルシクロヘキサン、ピス(4-ジ メチルアミノー2ーメチルフェニル) フェニルメタン、 ピス (4ージーp-トリルアミノフェニル) フェニルメ タン、N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ (4-メト キシフェニル) -4, 4' -ジアミノビフェニル、N, N, N', N' - F + 57x = 2 + 4 + 4 + 57x = 1フェニルエーテル、4,4'ービス(ジフェニルアミ ノ)クオードリフェニル、N, N, Nートリ(pートリ ル) アミン、4-(ジーp-トリルアミノ)-4'-[4 (ジーp-トリルアミノ) スチリル] スチルベン、 **4 -N, N-ジフェニルアミノー(2 - ジフェニルビニ** ル) ベンゼン、3-メトキシ-4'-N, N-ジフェニ ルアミノスチルベンゼン、N-フェニルカルバゾール等 を挙げることができる。また、発光層の材料として示し た前述の芳香族ジメチリディン系化合物も、正孔注入層 の材料として使用することができる。

【0045】正孔注入層としての厚さは特に制限されな 30 いが、通常は5 n m~5  $\mu$  mである。この正孔注入層は、上述した材料の1種または2種以上からなる一層構造であってもよいし、同一組成または異種組成の複数層からなる複層構造であってもよい。

# [0046] ⑤電子注入層

必要に応じて設けられる電子注入層は、陰極より注入された電子を発光層に伝達する機能を有していればよく、 その材料としては従来公知の化合物の中から任意のもの を選択して用いることができる。

【0047】具体例としては、二トロ置換フルオレノン 40 誘導体、特開昭57-149259号公報、同58-5 5450号公報、同63-104061号公報等に開示 されているアントラキノジメタン誘導体、Polymer Prep rints,Japan Vol.37,No.3(1988)p.681等に記載されてい るジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導 体、ナフタレンペリレン等の複素環テトラカルボン酸無 水物、カルボジイミド、Japanese Journal of Applied Physics,27,L 269(1988)、特開昭60-69657号公 報、同61-143764号公報、同61-14815 9号公報等に開示されているフルオレニリデンメタン誘 50

導体、特開昭61-225151号公報、同61-233750号公報等に開示されているアントラキノジメタン誘導体およびアントロン誘導体、Appl. Phys. Lett.,55,15,1489や前述の第38回応用物理学関係連合講演会で浜田らによって開示されたオキサジアゾール誘導体、特開昭59-194393号公報に開示されている一連の電子伝達性化合物等が挙げられる。なお、特開昭59-194393号公報では前記電子伝達性化合物を発光層の材料として開示しているが、本発明者の検討によれば、電子注入層の材料としても用いることができることが明らかとなった。

【0048】また、8ーキノリノール誘導体の金属錯体、具体的にはトリス(8ーキノリノール)アルミニウム、トリス(5,7ージクロロー8ーキノリノール)アルミニウム、トリス(5,7ージプロモー8ーキノリノール)アルミニウム、トリス(2ーメチルー8ーキノリノール)アルミニウム等や、これらの金属錯体の中心金属がIn、Mg、Cu、Ca、Sn、またはPbに置き代わった金属錯体等も電子注入層の材料として用いることができる。その他に、メタルフリーあるいはメタルフタロシアニンまたはそれらの末端がアルキル基、スルホン基等で置換されているものも望ましい。また、発光層の材料として例示したジスチリルピラジン誘導体も、電子注入層の材料として用いることができる。

【0049】電子注入層としての厚さは特に制限されないが、通常は $5nm\sim5\mu$ mである。この電子注入層は、上述した材料の1種または2種以上からなる一層構造であってもよいし、同一組成または異種組成の複数層からなる複層構造であってもよい。

【0050】次に、本発明に用いられる積層体(保護層および/または封止層)について、各発明ごとに図面を参照しながら具体的に説明する。保護層は、有機EL素子の作製時、電極端子取り付けの際の機械的障害および、酸素、水分の影響を防止するために使用される。封止層は、恒久的に外部の酸素、水分の影響を防ぐために使用される。

# 【0051】1.第一の発明

第一の発明の有機E L素子は、図1に示すように、積層体2として構造体1の外側に保護層3を介して封止層4を配設されている。この封止層4は、酸素吸収層41および酸素バリア層42を一組とした二重層の一組以上から構成されている。以下、保護層3及び封止層4についてさらに具体的に説明する。

# 【0052】1)保護層

封止層4を構成する材料自体の化学的性質から、またはその積層時の物理的接触から下側の構造体1に損傷を与えることがなければ必ずしも設ける必要はないが、構造体1の損傷を最小限におさえるという観点から設けることが好ましい。第一の発明の好ましい態様では、まず上述した構造体の外表面に電気絶縁性無機化合物からなる

保護層を設ける。保護層は、少なくとも対向電極の主表 面上に設けられていればよいが、構造体の外表面全面に 設けられていることが特に好ましい。また、構造上、対 向電極が発光層、正孔注入層または電子注入層のいずれ かの層の主表面の一部に設けられている有機EL素子で は、少なくとも、対向電極の下地となった層の主表面の うちで対向電極が設けられていない部分上と、対向電極 の主表面上とに保護層を設けることが好ましい。保護層 の材料である電気絶縁性無機化合物は、物理蒸着法(以 下、PVD法ということがある)により成膜可能な電気 絶縁性のものであればよく、具体例としてはMgO、G eO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, NiO, CaO, BaO, Fe<sub>2</sub>O <sub>3</sub>、Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、SiO<sub>2</sub>、酸化チタン等の酸化物や、A IN、BN、Si<sub>3</sub> N<sub>4</sub> 、Li<sub>3</sub>N等の窒化物、Si C、TiC等の炭化物、SrS、EuS、CuS、Zn S等の硫化物、またはMgF<sub>2</sub>、Mg(OH)<sub>2</sub>、Ba S〇』等、各種の電気絶縁性無機化合物を挙げることが できる。これらの電気絶縁性無機化合物のうち、反応性 蒸着法等により比較的マイルドな条件で成膜可能なGe O、MgO、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、NiO等の金属酸下物が特に 20 好ましい。

【0053】電気絶縁性無機化合物からなる保護層は、 用いる無機化合物に応じたPVD法により設けることが できる。保護層を設けた側を発光面とする場合には、有 機EL素子からのEL光に対する透光性に優れた保護層 が得られるように材料および形成方法を選択する。PV D法としては種々の方法が知られているが、真空蒸着法 またはスパッタ法を適用することが好ましい。それらは 例えば以下のように細分することができるが、いずれの 手法であっても適用することができる。

#### a. 真空蒸着法

抵抗加熱法、電子ビーム加熱法、高周波誘導加熱法、反 応性蒸着法、分子線エピタキシー法、ホットウォール蒸 着法、イオンプレーティング法、クラスターイオンビー ム法等

2極スパッタ法、2極マグネトロンスパッタ法、3極お

#### b. スパッタ法

よび4極プラズマスパッタ法、反応性スパッタ法、イオ ンピームスパッタ法、またはこれらを組合せた方法等 【0054】保護層の形成は、保護層を設けようとする 構造体を構成している有機物が変性しないように行うこ とが好ましい。有機物が変性しないための条件は、その 種類、換言すればその有機物が有する耐熱性などの特性 により異なるが、一般に有機物の温度を200℃以下に 保つことが好ましく、さらには100℃以下に保つこと が好ましい。もちろん、発光層等用の有機物として高分 子化合物のように熱に強い材料を使用したときは、この 限りでない。以下に、方法別に好ましい形成条件を述べ る。

①真空蒸着法

このなかでも好ましい方法は反応性蒸着法、電子ビーム 蒸着法であり、例えば反応性蒸着法で金属酸化物(Mg O) からなる保護膜を形成する場合を例にとると、蒸着 時間は2時間以下、好ましくは1時間以下がよい。さら に好ましくは20分以下がよい。蒸着前の真空チャンバ - 内の真空度は 1 × 1 0 <sup>-2</sup> P a 以下、特に 6 × 1 0 <sup>-3</sup> P a以下が好ましく、その後真空チャンバー内に酸素およ び/または水蒸気を導入した段階では真空チャンバー内 の圧力を7×10<sup>-3</sup>Pa以上、好ましくは1×10<sup>-2</sup>P a以上にし、この後、蒸着原料である金属Mgを100 0℃以下に加熱して蒸着する。蒸着速度は10nm/秒 以下、特に3nm/秒以下が好ましい。

#### ②スパッタ法

スパッタ法は、イオンでターゲットから堆積させたい物 質をはじき出すため、一般に真空蒸着法よりもエネルギ ーが高い。したがって真空蒸着法よりも条件は厳しい。 スパッタ法の中で特に好ましい方法は反応性スパッタ法 イオンビームスパッタ法である。反応性のイオンビーム スパッタ法でMgOからなる保護膜を形成する(酸素の イオンビームで金属Mgをスパッタリングしかつ酸化す る)場合を例にとると、蒸着時間は1時間以下、好まし くは30分以下、さらに好ましくは10分以下がよい。 また、酸素イオンの加速電圧は1200V以下、特に6 00 V以下が好ましく、ビーム電流は500mA以下、 特に60mA以下が好ましい。

【0055】上述のようにして形成される保護層の厚み は、蒸着速度と蒸着時間とのかねあいで決まる。保護層 は厚いほどその効果が期待できるが、厚い保護層を設け るためには蒸着時間を長くするか蒸着速度を早くしなけ ればならず、これに伴って構造体中の有機物のダメージ も大きくなる。したがって、保護層の厚みにも上限が必 要となる。例えば反応性蒸着法でMgOを成膜する場 合、最高の蒸着速度(10nm/秒)で成膜すると有機 物が受けるダメージが大きいため、この場合の蒸着時間 は20分以下にする必要がある。そして、この時の膜厚 の上限値は約12 mである。一方、保護層の厚みの下 限はその保護効果の有無により決まり、一般に約10 n m未満では薄すぎて保護層としての機能を十分に発揮す ることができない。なお、長寿命の有機EL素子を得る うえからは、保護層の形成過程での発光層や対向電極の 特性劣化をできるだけ抑止することが好ましく、そのた めには真空環境下で保護層を形成することが好ましい。 そして同様の理由から、構造体を構成する発光層の形成 から保護層の形成までを一連の真空環境下で行うことが 特に好ましい。

【0056】また、本発明においては保護層の他の材料 として、電気絶縁性高分子を好適に用いることができ る。この電気絶縁性高分子化合物は、物理蒸着法(以 下、PVD法ということがある) により成膜可能なも

50 の、化学気相密着法(以下、CVD法ということがあ

る)により成膜可能なもの、またはパーフルオロアルコール、パーフルオロエーテル、パーフルオロアミン等のフッ素系溶媒に可溶なものであればよいが、透湿度の小さなものが特に好ましい。各電気絶縁性高分子化合物の具体例としては、それぞれ以下のものを挙げることができる。

【0057】 ①PVD法により成膜可能な電気絶縁性高 分子化合物

ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド(二種類のモノマーを 10 基板上に堆積させて重合させたもの。テクニカルジャーナル、1988,30,22参照)、ポリユリア(二種類のモノマーを基板上に堆積させて重合させたもの。テクニカルジャーナル、1988,30,22参照)、特開昭63-18964号公報に開示されているフッ素系高分子化合物、特開昭63-2206号公報に開示されているフッ素系高分子化合物、特開昭63-238115号公報に開示されているフッ素系高分子化合物、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレンとの共重合体、環状構造を有する含フッ素共重合体(特願平3-129852号公報参照)等。

【0058】 ②CVD法 [プラズマ重合法(プラズマCVD)] により成膜可能な電気絶縁性高分子化合物 ポリエチレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリビニルトリメチルシラン、ポリメチルトリメトキシシラン、ポリシロキサン等。

【0059】③パーフルオロアルコール、パーフルオロエーテル、パーフルオロアミン等のフッ素系溶媒に可溶の電気絶縁性高分子化合物

特開昭63-18964号公報に開示されているフッ素 系高分子化合物、特開昭63-22206号公報に開示 されているフッ素系高分子化合物、特開昭63-238 115号公報に開示されているフッ素系高分子化合物、 ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリジクロロジフル オロエチレン、クロロトリフルオロエチレンとジクロロ ジフルオロエチレンとの共重合体、環状構造を有する含 フッ素共重合体(特願平3-129852号公報参照) 等のフッ素系高分子化合物。

【0060】保護層は、用いる高分子化合物に応じて、それぞれPVD法(上記①の高分子化合物)、CVD法(上記②の高分子化合物)、Hヤスト法またはスピンコート法(上記③の高分子化合物)により設けることができる。この場合の保護層の厚さは、用いる材料や形成方法にもよるが、10nm~100µmであることが好ましい。また、保護層を設けた側を発光面とする場合には、有機EL素子からのEL光に対する透光性に優れた保護層が得られるように材料及び形成方法を選択する。各方法による保護層の形成は、例えば以下のようにして50

行うことができる。

・PVD法は無機電気絶縁性高分子の場合と同じ方法を用いることができる。成膜条件は原料及び適用するPVD法の種類により異なるが、例えば真空蒸着法(抵抗加熱法、電子ビーム加熱法、高周波誘導加熱法)の場合は、蒸着前真空度は概ね1×10<sup>-2</sup>Pa以下好ましくは6×10<sup>-3</sup>Pa以下、蒸着源の加熱温度は概ね700℃以下好ましくは600℃以下、基板温度は概ね200℃以下好ましくは100℃以下であり、蒸着速度を50nm/秒以下好ましくは3nm/秒以下として成膜することが望ましい。

【0061】·CVD法

エチレン、プロピレン等の気体のモノマーをプラズマにより重合するプラズマ重合が好ましい。一般の熱分解CVDは基板温度が高温になるため不適である。

【0062】・キャスト法

原料をパーフルオロアルコール、パーフルオロエーテルまたはパーフルオロアミン等のフッ素系溶媒に溶解させ、この溶媒を構造体に展開した後、8~16時間風乾させることにより保護層を得る。乾燥時間は8時間以上であれば何時間でもよいが、16時間を超えて乾燥させても乾燥の程度に大きな差はでないので不適である。乾燥時間は通蔵12時間程度が適当である。溶液中の原料の濃度は目的とする保護層の厚さに応じて適宜選択される。

【0063】・スピンコート法

上記キャスト法の場合と同様にして得た溶液を、100~2000rpm好ましくは200~8000rpmで回転させている構造体上に適当量滴下し、この構造体をそのままさらに5~60秒好ましくは10~30秒回転させた後、キャスト法の場合と同様にして乾燥させることにより保護層を得る。このときの溶液の滴下量は、構造体あるいは封止しようとする有機EL素子の大きさにより異なるが、通常のスライドガラスの大きさ(25×75×1.1mm)の構造体または有機EL素子での.6~6ml、好ましくは0.5~3mlである。溶液中の原料の濃度はキャスト法の場合と同様に、目的とする保護層の厚さに応じて適宜選択されるが、その範囲はキャスト法の場合より狭く、膜厚の制御や膜の均一性等の点から、1~40g/100ml好ましくは4~20g/100mlである。

【0064】なお、キャスト法及びスピンコート法のいずれの方法においても、風乾後に真空乾燥機等を用いて30~100℃好ましくは50~80℃で、1~24時間好ましくは8~16時間、さらに乾燥することが好ましい。

【0065】2) 封止層

①構成:前記保護層3の上に構造体1の陰極13側に近い方から、酸素吸収層41と酸素バリアー層42とを、この順に有する二重層の組を一組以上積層する。

②膜厚:一組が数~数百μmが好ましい。

③積層方法:積層時の構造体の損傷をできるだけ抑える 積層方法を採用することが好ましい。保護層と同様な積 層方法を用いることができる。他には、高分子の塗布方 法として知られている、浸漬法、スピンコーティング方 法等を用いることができる。

②酸素吸収層:酸素吸収層41に用いられる材料としては、(i)イオン化ポテンシャルイの小さい有機化合物、例えば電子写真感光体の正孔輸送材料、アミン系化合物、ヒドラゾン化合物等、(ii)酸素吸着性化合物、(iii)フッ素系化合物、例えばフッ素化炭化水素の不活性液体等、(iv)金属微粉末、例えば粒径が数μm程度のFe,Co,Ni,Cu、及びアルカリ金属、希土類金属等、仕事関数の小さい金属例えば、A1,In,Mg,Yb,Zi,Na,K等を挙げることができる。酸素の吸収層の形態としては、上記物質の単体の固体(蒸着膜、スパッター膜等)液体、または高分子への分散膜(ブチラール樹脂,PC,PS等)を挙げることができる。

#### ⑤酸素バリアー層

酸素バリアー層としては、保護層として用いた金属酸化物,窒化物,フッ化物、酸素透過係数の小さいことが知られている物質、例えばポリビニルアルコール,ブチルゴム,ポリエチレン,ポリニトリル系樹脂,ポリ塩化ビニリデン(サラン)、ナイロン-6等のポリアミド系樹脂等、半導体素子のパッシュベーション膜として公知な、Si系窒化物等を挙げることができる。酸素バリアー層の形態としては、上記物質の蒸着膜,スパッタ膜,高分子塗布膜等を挙げることができる。

⑥なお、この他に必要に応じてこの封止層4の外側にさ 30 のらにガラスや樹脂によってフレーム5を設けてもよい。 【【○○66】2. 第二の発明 N

第二の発明の有機E L素子は、図2に示すように、積層体2の保護層3および/または封止層4の少なくとも一方が、酸素を吸着、吸蔵または消費する材料6を含有することを特徴とする。この第二の発明においては、保護層と封止層との厳密な区別をする必要はない。また一方だけを設けてもよい。なお、接着層7は、封止層として固形物を用いた場合、より強力に基板との封止を行うために使用することが好ましい。封止層を接着層と兼用させてもよい。これらの保護層および封止層のいずれか

(以下、保護封止層 2'という)の中に酸素を吸着、吸蔵または消費する材料を含有させることにより、微量の素子の内部の酸素を吸着、吸蔵または消費させて、電極や有機材料への酸素の影響を防止する。接着層の中に酸素を吸着等する物質を含有させてもよい。酸素の吸着方法としては物理吸着、化学吸着のいずれでもよい。なお、酸素の吸蔵とは物理的または化学的に酸素が取りこまれることをいい、その方法としては、例えば包接、インターカレーション、吸着を挙げることができる。酸素 50

をの消費とは、化学反応による酸素の消費のことをい い、その方法としては、例えば水酸化、過酸化、水和な どの酸素や配位を挙げることができる。保護封止層の形 態としては、基板や構造体を被覆できるものであるなら ば特に制限はない。保護封止層が、金属の板状物、金属 薄膜、樹脂製フィルム、樹脂成形品、ガラス製品からな る場合、酸素吸着剤等を塗布したり、マイクロカプセル 化して、塗布、または蒸着させてもよい。また保護層お よび封止層の二つを区別して設けた場合、その間に挿入 してもよい。また、保護封止層がゲル状、半ねり状、液 状の物質からなる場合、酸素吸着剤等を混練して分散し て使用することができる。また、熱硬化性樹脂、光硬化 性樹脂、または反応性の樹脂等を用いて保護封止層を作 製する場合、酸素吸着剤等を原料に混練し、分散して使 用することができる。保護封止層を基板に接着する場 合、種々の接着剤を使用することができるが、接着剤の 中に酸素吸着剤等を混練して使用してもよい。酸素吸着 剤等の含有量は、保護封止層中10重量%以下であるこ とが好ましい。10重量%を超えると、保護封止層の均 一性が損なわれることがある。0.01~5%がさらに 好ましい。

【0067】酸素を吸着、吸蔵、または消費する材料としては、たとえば以下の物質を挙げることができる。 ①酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、酸化鉄、酸化チタン、ベントナイト、酸性白土、モンモリロナイト、ケイソウ土(粘土鉱物)、活性アルミナ、シリカアルミナ、ゼオライト、シリカ、ジルコニア、活性炭(不活性ガス中120℃以上の温度で焼成したものが好ましい。)からなる群から選ばれる一以上の物質からなるものの

【0068】②周期律表第四周期の金属(Fe, Co, Ni, Mn, Cr, V, Zn, Cu)の微粉末、薄膜、その金属塩、もしくはその酸化物、または周期律表第四周期の金属(Fe, Co, Ni, Mn, Cr, V, Zn, Cu)、その金属塩もしくはその酸化物を酸化マグネシウム,炭酸マグネシウム,酸化鉄,酸化チタン、ベントナイト,酸性白土,モンモリロナイト,ケイソウ土(粘土鉱物),活性アルミナ,シリカアルミナ,ゼオライト,シリカ,ジルコニア,活性炭(不活性ガス中120℃以上の温度で焼成したものが好ましい。)からなる群から選ばれる一以上の物質からなるものに担持した物質

担持する濃度は10重量%以下が好ましく5%以下がさらに好ましい。たとえば、酸化コバルト(II) CoO結晶を挙げることができる。この物質は、酸素を吸着する結晶性の化合物で酸素と以下の反応式で反応する。CoO+1/4O,  $\rightarrow 1/2Co_2O_3$ 

【0069】 ②炭素数が3~30の一級または二級の炭素を持つ炭化水素、たとえば、アルキルシクロヘキサン、アルカン、アルケン、クメン等を、周期律表第四周

期の金属の微粉末、薄膜、その金属塩もしくはその酸化 物、または周期律表第四周期の金属の微粉末、薄膜、そ の金属塩もしくはその酸化物を、酸化マグネシウム,炭 酸マグネシウム、酸化鉄、酸化チタン、ベントナイト、 酸性白土、モンモリロナイト、ケイソウ土(粘土鉱 物),活性アルミナ、シリカアルミナ、ゼオライト、シ リカ、ジルコニア及び活性炭からなる群から選ばれる一 以上の物質に10重量%以下の濃度で担持させたもの、 又は活性炭に1重量%以下の濃度で含浸させた物質 【0070】④白金、パラジウム、ロジウム、ルチニウ ムまたは銀を、好ましくは5重量%以下(さらに好まし くは1重量%以下0.001重量%以上)の濃度で酸化 マグネシウム,炭酸マグネシウム,酸化鉄,酸化チタ ン、ベントナイト、酸性白土、モンモリロナイト、ケイ ソウ土(粘土鉱物), 活性アルミナ, シリカアルミナ, ゼオライト,シリカ,ジルコニア及び活性炭からなる群 から選ばれる一以上の物質に担持させた物質

【0071】このような物質を本発明において好適に用\*

\* いることができる理由を以下説明する。<br/>
①の場合、表面 積の大きい化合物は酸素や有機物分子を吸着する能力が ある。②の場合、金属自身、酸素によって酸化されるこ とにより酸素を消費する。また金属、金属塩、金属酸化 物は酸素を吸着する能力がある。酸化コバルト(II)の 場合は、結晶が酸素を吸収して別の結晶になる反応を利 用したものである。③の場合、アルカンやアルケンの存 在により、金属は触媒作用を示し、下記式に示すような 反応により酸素を消費する。特に無機物に担持された金 属の場合、これらの生成物も酸素を吸着して酸素を系外 に出すことはないので優れている。

[0072]  
[化1]  
$$R-CH_2-R$$
  $\xrightarrow{O_2}$   $R-CH-R$   $\xrightarrow{O-OH}$ 

[0073] 【化2】  $\Rightarrow$  R-CH-CH-R

$$\begin{array}{c} H_2O \\ > R - CH - CH - R \\ \downarrow \\ OH OH \end{array}$$

[0074] ④の場合、②、③と同様の能力がある。特 に活性炭を担体に用いた場合、その表面積の広さから効 果的である。また

1/20, +C→CO

の反応も起り、一酸化炭素はそのまま、活性炭中へ吸着 される。

【0075】3. 第三の発明

第三の発明に用いられる保護層は図3に示すように脱水 剤31を含有する。第三の発明に用いられる保護層3の 基材としては、室温で固体のものであれば特に制限はな く、例えばポリオレフィン、ポリエーテル、ポリカーボ ネート、ポリアミド等のポリマー、デュポン社製、商品 名:テフロンAFのようなアモルファス状の有機物、ア ルミや鉛等の金属膜、または $\alpha-Si:\alpha-SiC$ 、 $\alpha$ -C、Ge〇のような無機物を用いることができる。中 でもテフロンAFが特に好ましい。また、保護層の作製 法としては、特に制限はなく、たとえば塗布法、蒸着 法、スピンコート法、スパッタリング、CVD法等を挙 げることができるが有機発光材料は熱に弱いため、スピ ンコート法が好ましい。保護層中に含有させる脱水剤3 1としては、例えば、塩の無水物(無水硫酸マグネシウ ム、無水硫酸ナトリウム等)、塩化物(塩化カルシウ ム、塩化リチウム等)酸化物(酸化カルシウム等)、シ リカゲル、ゼオライト、モレキュラーシーブ、活性炭、 グラファイト等を用いることができるが、アルカリ金属 またはアルカリ土類金属(ナトリウム、カリウム、カル シウム、マグネシウム等)が特に好ましい。脱水剤の含 有量は、保護層中、10重量%以下である。10重量% を超えた量の脱水剤は保護層を不安定化させることがあ る。なお、脱水剤31を含有する保護層3の外側に、さ らに、封止層等を設けてもよい。

【0076】4. 第四の発明

第四の発明に用いられる封止層は、図4に示すように、 無機組成物44を含有する光または熱硬化性樹脂層43 からなる。また、必要に応じてこの封止層4の上に他の 封止層を積層してもよい。また、この封止層4の下側に 保護層を設けてもよい。無機組成物44としては、金属 **微粒子、無機酸化物粒子等を挙げることができる。具体** 的には、アルミナ、シリカガラス、コロイダルシリカ、 ホウケイ酸ガラス、β-ユークリプタイト、バリウムガ ラス,チッ化ケイ素,チッ化ベリリウム,炭化ケイ素等 の粒子を挙げることができる。これらの無機組成物は、 全封止層に対し50重量%以上95重量%以下の組成比 であることが好ましく、60重量%以上85重量%以下 の組成比であることがさらに好ましい。光硬化性樹脂と しては、特に制限はなく、硬化前の組成として少なくと も、多官能性モノマー,光重合開始剤(光増感剤), 環 元剤,重合禁止剤等からなるものが好ましい。光の波長 域としては特に制限はないが好ましくは、可視光領域 (380~650 nm) で反応する成分を含有するのが

好ましい。封止層4を上記の組成により制御することに より均一な膜を形成し、封止層の硬化(重合)時におけ る収縮率や熱膨張係数を制御することができ、素子にあ たえる応力に伴なう劣化を抑制することができる。前述 のように、このような無機組成物44を含有する光硬化 性樹脂層43からなる封止層4上に他の封止層を積層し てもよい。他の封止層としては、例えば酸素バリアー 層、撥水層、酸素吸着層、吸湿層等を挙げることができ る。また、上記光または熱硬化性樹脂は、硬化前は流動 性であるために、有機EL素子を設置する状況に応じて 背後面の形状をかえて硬化することが可能である。この ため、上記の他の封止層を積層する場合も、初期に流動 性を有し、かつ適当な処理を行なうことにより固化しう る材料や可撓性を有するフィルムが好ましい。このよう な光硬化性樹脂または熱硬化性樹脂としては、たとえば ブチルゴム系樹脂、スチレンブタジエンゴム系樹脂、ク ロロプレン系樹脂、アクリル系樹脂、エポキシ樹脂、フ ッ素系樹脂、シリコーン系樹脂などを例示することがで きる。さらに、上記材料は電気絶縁性に優れ、硬化の際 に副産物の発生のないものであることが好ましく、この 20 ことから特にエポキシ系樹脂,シリコーン系樹脂が好ま しい。

#### 【0077】5. 第五の発明

第五の発明に用いられる積層体は、図5に示すように、酸素透過係数が $1 \times 10^{-12}$  c c · c m/c m $^2$  · s ·

(cmHg)以下である有機層22を少なくとも一層設 けたものからなる。この有機層22の上又は下側に、さ らに耐水性の封止層を積層するのが好ましい。また、こ の有機層22の下側に保護層を設けてもよい。図5に示 す具体例のほかに図6及び図7に示す構成であってもよ い。酸素透過係数の測定法としては、例えば、高分子化 学第16巻第168号(1959)に記載されている方 法、J. Polym. Sci. part2A-2 vol.8 p.467 (197 0) に記載されている方法等を挙げることができる。 具 体的な材料としては、ポリビニリデンクロライド(商品 名:サラン),ポリピニルクロライド,ポリピニルアル コール、セルロース、セロファン、酢酸繊維等の薄膜を 挙げることができる。その成膜法としては、特に制限は なく、蒸着法、重合法、スパッタ法、キャスト法、スピ ンコート法等を用いることができる。なお、その他の方 法として、上記材料からなるフィルムを熱圧着する方法 であってもよい。さらに、湿式法(例えばキャスト法、 スピンコート法) を用いる場合、あらかじめ耐水性耐薬 品件の封止層を形成後成膜するのが好ましい。以上、各 発明ごとに説明したが、第一から第五までの発明を適宜 組み合わせたものであってもよい。

## [0078]

【実施例】以下、本発明を実施例によってさらに具体的 に説明する。

## [実施例 []

有機EL素子の構造体の作製 25×75×1. 1mmのサイズのガラス板(HOYA **社製の白板ガラス)を基板として用い、この基板上に I** TO膜を100nmの厚さで成膜して透明電極とした (以下、ITO膜が成膜された基板を透明支持基板とい う)。この透明支持基板をイソプロピルアルコールで3 0分間超音波洗浄した後、純水で5分間洗浄し、その後 イソプロピルアルコールでリンスした後に乾燥N2 ガス を吹き付けて乾燥させた。最後にUVオゾン洗浄装置 (サムコインターナショナル社製) で10分間洗浄し た。洗浄後の透明支持基板を市販の真空蒸着装置(日本 真空技術社製)の基板ホルダーに固定し、モリブデン製 抵抗加熱ボートにN, N' -ジフェニル-N, N' -ビ スー(3-メチルフェニル)ー[1,1'ービフェニ ル] -4, 4' -ジアミン(以下、TPDという)を2 00mg入れ、また違うモリブデン製抵抗加熱ボートに トリス (8-キノリノール) アルミニウム (以下、A1 q. という)を200mg入れて、真空チャンパー内を 1×10<sup>-4</sup> P a まで減圧した。

【0079】次いで、TPDを入れた前記抵抗加熱ボー トを215~220℃まで加熱して、TPDを蒸着速度 0.1~0.3 n m/砂で透明支持基板のITO膜上に 堆積させて、膜厚60nmの正孔注入層を成膜した。こ のときの基板温度は室温であった。次いで、正孔注入層 が成膜された透明支持基板を基板ホルダーに固定したま ま、Alq. を入れたモリブデン製抵抗加熱ボートを2 75℃まで加熱して、Alq. を蒸着速度0.1~0. 2 nm/秒で正孔注入層上に堆積させて、膜厚60 nm の発光層を成膜した。このときの基板温度も室温であっ た。次に、マグネシウム(Mg)1gを予め入れておい たモリブデン製抵抗加熱ボートと銀(Ag) 500mg を予め入れておいたモリブデン製抵抗加熱ボートとをそ れぞれ加熱し、Mgを1.6nm/秒の蒸着速度で蒸着 させ、同時にAgを0.1 n m/秒の蒸着速度で蒸着さ せて、MgとAgとの混合金属からなる膜厚160nm の電極(対向電極)を発光層上に設けた。ガラス基板上 にITO膜(電極)、正孔注入層、発光層、および対向 電極を設けたことで有機EL素子が得られた。なお、こ の構造体では、ガラス基板上に設けられたITO膜、正 孔注入層、発光層、および対応電極により積層構造体が 形成されている。ここで、ITO上及びITO上にはな いMg:Ag面よりIn圧着により導線をとり出した。 この状態でもう一度、真空槽に戻し、1×10<sup>-4</sup>Paま で減圧した。

# 【0080】保護層の形成

真空チャンパー内に酸素を導入して、真空チャンパー内の圧力を8×10<sup>-3</sup>Paにした。次いで、Mgが入ったモリブデン製抵抗加熱ボート(対向電極作製時のもの)を485℃に加熱して、Mgを0.5nm/砂の蒸着速50度で蒸着させるとともに真空チャンパー内の酸素と反応

させて、積層構造体の外表面に膜厚0.3μm (300 nm)のMgO膜(保護層)を設けた。

【0081】酸素吸着層・酸素パリアー層の形成 その後再度1×10<sup>-4</sup>Paまで減圧してMgを1nm/\* \* 秒の蒸着速度で0.5 m酸素吸着層として蒸着した。 その後再度上記MgOを同様な方法で酸素パリアー層と して0.5μm積層成膜した。上記、封止層まで積層 後、素子を発光させた。

電圧(V)	電流密度(mA/cm <sup>2</sup> )	輝度(cd/m²)	発光効率(lm/w)
6	10.3	290	1. 47

において、無発光点の数は5個しか見あたらず、均一性 がかなり良好な発光であった。後述する比較例1の結果 より、保護層及び封止層の積層により、発光性能及び発 光均一性は損なわれていないことがわかった。 ж

なお、発光面内(0.3 c  $\mathrm{m}^2$  )には、1 0 倍の拡大像 10% 【0 0 8 2】 [実施例 2] 実施例 1 のM g O (酸素バリ アー層)の上に、さらに第二のくり返し単位としてM g, Mg〇を同一の方法により同一膜厚で積層した。封 止終了後の素子性能は、以下の様に殆ど実施例1と同様 であった。

電圧(V)	電流密度(mA/cm <sup>2</sup> )	輝度(cd/m²) 発光効率(lm/w		*無発光点の数 
6	10.0	270	1.45	7個

\* 以下実施例1と同様、10倍の拡大像にて観察 【0083】 [実施例3] 実施例1の酸素吸収層のMg の代わりにポリカーボード樹脂(Pc)へのFe微粉末 分散膜を以下の手順で100μm積層した。Feの平均 粒径は5μm, 分散濃度はPc:Fe=50:30重量 %の条件で、CH2 Cl2 溶液から浸漬塗布法により成★

20★膜した。次に酸素バリアー層として高密度ポリエチレン (出光石油化学社製、商品名:440M)を1×10<sup>-2</sup> Paの真空中、アルミナるつぼに仕込んで真空蒸着法 (るつぼ温度:3 7 0 ℃) により 1 0 μ m積層した。封 止終了後の素子性能は以下の通りで、実施例1及び2と 同様であった。

電圧(V)	電流密度(mA/cm <sup>2</sup> )	輝度(cd/m²)	発光効率(lm/w)	無発光点の数
6	10.5	287	1. 43	8個

【0084】 [比較例1] 保護層及び封止層(酸素吸収 層と酸素バリアー層)を設けなかったこと以外は実施例☆ ☆1と同様にして有機EL素子を作製した。素子性能は以 下の通りであった。

電圧(V)	電流密度(mA/cm <sup>2</sup> )	輝度(cd/m²)	発光効率(lm/w)	無発光点の数 
6	10.6	3 0 4	1.50	3個 

◆は、比較例1とほぼ同様であった。 【0085】 [比較例2] 保護層のみを積層したこと以 外は実施例1と同様にして素子を作製した。発光性能

実施例2

電圧(V)	電流密度(mA/cm <sup>2</sup> )	輝度(cd/m²)	発光効率(lm/w)	無発光点の数
6	10.5	300	1.50	4個 

【0086】ダークスポット抑制効果の確認 素子作製終了後、大気中、室温(23℃)にて、定電流 連続駆動により発光面の均一性の変化を観測した。素子 作製1000時間後無発光点の数は以下のようになっ \*

実施例1

\*た。測定は実施例、比較例と同様10倍の拡大視野にて 行った。なお、カッコ内の数字は初期の値から増加した 数を示す。

比較例2 比較例1 実施例3

10 (5)

105 (92) 70 (66)

この結果により酸素吸収層及び酸素バリアー層から成る 封止層により有効に、無発光点の発生が抑制されている

11(4)

[0087] 輝度低下抑制効果の確認

ことがわかった。

\* 大気中、室温(23℃)にて、初期100cd/m³の 輝度から、定電流連続駆動により輝度の変化を測定し た。

28

	輝度の半減時間(時間)	素子の震壊時間(時間)
実施例1	4,600	15,000
実施例2	9,300	20,000
実施例3	7,500	17,000
比較例1	212	953
比較例2	508	12,000

9 (1)

酸素吸収層及び酸素バリアー層から成る封止層により、 輝度の低下が有効に抑えられることがわかった。

【0088】 [実施例4]

#### 有機EL素子の構造体の作製

25mm×75mm×1.1mmのサイズのガラス基板 状にIT〇電極を100nmの厚さで成膜したものを透 明支持基板とした。これをイソプロピルアルコールで3 0分間超音波洗浄した後、純水で30分間洗浄し最後に 再びイソプロピルアルコールで30分間長音波洗浄し た。そしてこの透明支持基板を市販の真空蒸着装置(日 本真空技術社製)の基板ホルダーに固定し、モリブデン 製の抵抗加熱ボートにN, N'ージフェニルーN, N' ーピスー (3-メチルフェニル) - [1, 1'ーピフェ ニル] -4, 4' -ジアミン (TPD) を200mgい れ、また違うモリブデン製抵抗加熱ボートにトリス(8) ーキノリノール) アルミニウム (Alq.) を200m g入れ真空チャンバー内を1×10<sup>-4</sup>Paまで減圧し た。その後TPD入りの前記ボート215~220℃ま で加熱しTPDを蒸着速度0.1~0.3 n m/秒で基 板上に堆積させ、膜厚60mmの正孔注入層を成膜し た。このときの基板温度は室温であった。これを真空層 から取り出すことなく正孔注入層の上に、もう一つのボ ートよりAla.を発光層として60nm積層蒸着し た。蒸着条件は、ボート温度が275℃で蒸着速度が 0.1~0.2 nm、基板温度は室温であった。次に、 モリブデン製抵抗加熱ボートにマグネシウム1gを入 れ、また別のモリブデン製抵抗加熱ボートにインジウム 500mgをいれた。その後真空層を2×10<sup>-4</sup>Paま で減圧してインジウムを0.03~0.08 n m/秒の 蒸着速度で蒸発させ同時に抵抗加熱法によりもう一方の モリブデン製ポートからマグネシウムを1.7~2.8 nm/秒の蒸着速度で蒸着した。マグネシウム、インジ ウムのボート温度は、それぞれ500℃、800℃程度 であった。以上の条件でマグネシウムとインジウムの混 50

合金属電極を発光層のうえに150nm積層蒸着し対向電極とした。ITO/TPD/Alq/Mg:Inの素子構成の有機EL素子の構造体ができた。この有機EL素子の初期性能は電圧7V、電流密度3.6mA/cm<sup>2</sup>、輝度105cd/m<sup>3</sup>で電力変換効率1.3 lm/Wであった。

### 【0089】保護封止層の形成

住友スリーエム社製、商品名:フロリナートFC-48、100mlに、テトラフルオロエチレンとパーフルオロー2、2ージメチルー1、3ージオキソールとの無定形共重合体粉末(デュポン社製、商品名:テフロンAFNo.1600)50gを溶解させた溶液を窒素ガスを流通させたグローボックスにいれ、白金5重量%を担持した活性炭(和光純薬社製)1gを乳鉢で粉体にした後、加えて攪拌分散した。次に、この溶液を上記の構造体に塗布してキャスト膜を作製し保護封止層とした(膜厚10ミクロン)。

【0090】 [実施例5] イソオクタン0.01gをエーテル5mlに溶かした溶液にパラジウム0.1重量%担持活性炭1gを加えて含浸させた後、窒素ガスを流通させた焼成炉で100℃30分間乾燥させ、乳鉢で粉体にした後、窒素ガスを流通させたグローボックス中でデュポン社製テフロンAFNo.1600、50gを溶解させた住友スリーエム社製フロリナートFCー43、溶液140mlに加え、攪拌分散した。次に、この溶液を実施例4で用いた構造体に塗布してキャスト膜を作製し保護封止層とした(膜厚0.2ミリ)。

【0091】 [実施例6] 住友スリーエム社製、商品名:フロリナートFC-43、100mlにデュポン社製デフロンAFNo. 1600、50gを溶解させた溶液に一酸化コバルト(II)の粉末0.5gを実施例4と同様の方法で分散させ、この溶液を実施例4で用いた構造体に塗布してキャスト膜を作製し保護封止層とした(膜厚0.5ミリ)。

0 (15

【0092】 [実施例7] シュウ酸バナジウム0. 1g を蒸留水10mlに溶解させ、活性アルミナ(和光純薬 社製、商品名:ワコーゲルQ-50)10gを加えて攪 拌し、蒸発皿で乾固させた後、電気炉に入れ、600℃ で2時間に加熱した。得られた黄色粉末を、窒素ガスを 流通させたグローボックス中で50℃に加熱したパラフ ィン (m. p. =42~44℃) に加えて混練した。こ の溶液を実施例4で用いた構造体に塗布し、放冷して厚 膜を作製し保護封止層とした(膜厚約1ミリ)。

【0093】 [比較例3] 住友スリーエム社製フロリナ ートFC-43、100m1にテトラフオロエチレンと パーフルオロー2、2ージメチルー1,3ージオキソー ルとの無定形共重合体粉末 (デュポン社製、商品名:テ\*

\*フロンAFNo.1600)50gを溶解させた溶液を 窒素ガスを流通させたグローボックスにいれ、この溶液 を実施例4で用いた構造体に塗布してキャスト膜を作製 し保護封止層とした(膜厚10ミクロン)。

【0094】 [比較例4] 窒素ガスを流通させたグロー ボックス中で50℃に加熱したパラフィン(m. p. = 42~44℃)を実施例4で用いた構造体に塗布し、放 冷して厚膜を作製し保護封止層とした(膜厚約1ミ リ)。実施例4~7 および比較例3~4 の有機E L素子

を窒素ガスを流通させたグローボックス中で、初期輝度 100 c  $\mathrm{d/m^2}$  で定電流連続駆動および1 ケ月毎の非 定常駆動を行った。

		連	続	駆	動	1 ケ月毎の非定常駆動 (保存寿命)
	—— 半	減寿命	_	破	<b>壊寿命</b>	
実施例4 実施例5 実施例6 実施例7 比較例3	5, 4,	500時 000時 000時 000時 150時	計問 計問 計問	20, 20, 10, 2,	000時間以 000時間以 000時間以 000時間以 000時間以	上       12ヶ月後変化なし         上       12ヶ月後変化なし         上       15ヶ月後変化なし         上       1ヶ月後         ダークスポット発生

このように単に保護封止層をつけるよりも、その中に脱 酸素剤等を含有させることにより半減寿命、破壊寿命、 保存寿命の延長に効果がみられた。

【0095】 [実施例8]

有機EL素子の構造体の作製

基板ガラスに1000AのITO(酸化インジウムー酸 化錫)膜を形成した透明電極付きガラス基板(松崎真空 社製) をアセトン中で超音波洗浄し、次いで、エタノー ル中で煮沸処理した。さらに、空気組成のプラズマ処理 をした。この表面処理した透明電極付きガラス基板を真 空装置にセットし、 $5 \times 10^{-6}$ torrの真空度でN, N' ージフェニルーN, N' - (3-メチルフェニル) **−1, 1'−ピフェニル−4, 4'−ジアミン(以下**T PDという)を200A蒸着し、引続きTPDと8ーオ キシキノリンのアルミニウム錯体(以下Al q³ とい う)との成分が連続して変化する濃度勾配を持つ部分 (傾斜構造部) 100Åを形成し、引き続きAlq<sup>3</sup>を 200A蒸着した。さらに、マグネシウム(Mg)と銀 (Ag) を10:1の原子比で200nm共蒸着して有 機EL素子の構造体を作製した。

【0096】保護層の形成

次に、住友スリーエム社製フロリナートFC-72中 に、デュポン社製テフロンAFNo. 1600、とマグ 50

ネシウム粉末を重量比で100:1になるような比で分 散させ、これをスポイトを用いて得られた構造体上に静 かに塗布し、乾くのを待って数回同じ操作を繰り返して 保護層を形成した。以上の操作は全て窒素雰囲気中で行 った。このようにして作成した有機EL素子は完全固体 素子であるため取り扱い易く、液漏れの心配もない。ま た、この素子を室温、空気中に放置したとこり、半年 後、直流電圧をかけたところ、均一に発光し素子に欠陥 を生じなかった。

【0097】 [比較例5] 実施例8の素子の保護層にで グネシウム粉末を添加しないこと以外は全く同じ操作で 素子を作製し、空気中に放置した素子を発光させたとこ ろ1ヶ月で素子の表面に肉眼でも見える大きさの黒い欠 陥が多数生じた。

【0098】 [実施例9] 実施例8で用いた脱水剤とし てのマグネシウムをモレキュラーシーブ4A(広島和光 社製) に代えた以外は同様にして素子を作製した。その 結果、4ヶ月間素子に欠陥が生じなかった。

【0099】 [実施例10] 実施例8で用いた脱水剤と してのマグネシウムを無水硫酸マグネシウム(広島和光 社製) に代えた以外は同様にして素子を作製した。その 結果、3ケ月問素子に欠陥が生じなかった。

脱水剤	性能*	
Mg	6 ケ月間欠陥なし	実施例 8
モレキュラーシーブ4A	4 ケ月間欠陥なし	実施例 9
無水MgSO <sub>4</sub>	3 ケ月間欠陥なし	実施例 1 0
なし	1 ケ月で欠陥生成	比較例 5

なお、性能は直流電圧10Vを印加した時の発光面の状 態を観察した。

【0100】 [実施例11]

## 有機EL素子の構造体の作製

25mm×75mm×1.1mmのガラス基板上にIT 〇を蒸着法により10nmの厚さで製膜したものを透明 支持基板とした。この透明支持基板をイソプロピルアル コール中にて5分間洗浄後に、純水中で5分間超音波洗 浄を行ない、さらにUVオゾン洗浄を5分間行なった。 このUVオゾン洗浄には、株式会社サムコインターナシ ョナル研究所製の装置を用いた。この透明支持基板を市 販の蒸着装置(日本真空技術社製)の基板ホルダに固定 20 して、モリブデン製の抵抗加熱ボートにN, N'ービス (3-メチルフェニル)-N, N'-ジフェニル[1,1'-ピフェニル]-4,4'-ジアミン(TPD)を 200mg入れ、また違うモリブデン製ポートに4, 4' -ピス (2, 2' -ジフェニルビニル) ビフェニル (DPVBi) を200mg入れて真空槽を1×10<sup>-4</sup> Paまで減圧した。その後、TPD入りの上記ボートを 215~220℃まで加熱し、TPDを蒸着速度0.1 ~0.3 n m/秒で透明支持基板上に蒸着して、膜厚6 0 n mの正孔注入層を成膜した。このときの基板温度は 室温であった。これを真空槽から取り出すことなく、正 孔注入層の上に、もう一つのボートよりDPVBiを発 光層として40mm積層蒸着した。蒸着条件はボート温 度が240℃であり、蒸着速度は0.1~0.3nm/ 秒、基板温度は室温であった。これを真空槽から取り出 して、上記発光層の上にステンレススチール製のマスク を設置し、再び基板ホルダに固定した。次に、モリブデ ン製ボートにトリス (8ーキノリノール) アルミニウム (Alq<sup>3</sup>) を200mg入れて真空槽に装着した。さ らに、モリブデン製の抵抗加熱ポートにマグネシウムリ ボンを1g入れ、また違うタングステン製のバスケット に銀ワイヤを500mg入れ蒸着した。その後、真空槽 を1×10<sup>-4</sup>Paまで減圧してから、Alq<sup>3</sup>の入った ボートを230℃まで加熱し、Alq<sup>3</sup>を0.01~ 0.03nm/秒の蒸着速度で20nm蒸着した。さら に、銀を0.01nm/秒の蒸着速度で同時に抵抗加熱 法により、もう一方のモリブデンボートからマグネシウ ムを1.4 nm/秒の蒸着速度で蒸着し始めた。上記条 件でマグネシウムと銀の混合金属電極を発光層の上に1 50nmの厚さで積層蒸着し、対向電極とした。この素 50

子の構造体を乾燥窒素中にて、0 Vから10 V、0 Vか ら-10 Vへ0. 5 V間隔で5秒ずつで印加し、エージ 10 ングを行なった。

## 【00101】封止層の形成

次に、封止層として可視光硬化型接着剤(東亜合成化学 工業社製商品名アロンタイトVL) へ平均粒径1 μ mの シリカガラス(触媒化成社製)を70重量%の比率で混 合した。この封止層を上記作製の素子の構造体の有機多 層部及び電極を覆うように滴下し、太陽光により硬化さ せ、厚さ1mmの封止層を形成した。

【0102】 [比較例6] 実施例11と同じ構成、工程 で素子の構造体を作製した。封止層として東亜合成化学 工業社製、商品名アロンタイトVLを用い、構造体の上 に実施例11と同じ条件で封止層を形成した。実施例1 1及び比較例6の封止した素子をそれぞれ50個ずつ作 製したところ、封止によりショート、または機械的破壊 により全く発光性能をもたなくなった素子は実施例11 では5個、比較例6では40個であった。また、実施例 11及び比較例6の封止した素子をそれぞれ10個ずつ 耐久試験装置(タバエエスペック社製SH-220)内 に設置し、温度を25℃→60℃を30分、60℃→2 5℃を30分変化させる熱サイクルを10回繰り返す熱 サイクル耐久試験を行なった。この結果、まったく発光 性能を持たなくなった素子は実施例11で2個、比較例 6で7個あった。上記二つの試験結果より、明らかに実 施例11は比較例6に比べて作製時の歩留まりの向上、 熱サイクルに対する耐久性の向上がみられた。

# 【0103】 [実施例12]

#### 有機EL素子の構造体の作製

40

基板ガラスに1000AのITO(酸化インジウム-酸 化錫)膜を形成した透明電極付きガラス基板(ジオマテ ィック社製)をアセトン中で超音波洗浄し、次いで、U V洗浄装置(株式会社サムコインターナショナル研究所 社製UV-300)にて洗浄した。この表面処理した透 明電極付きガラス基板を真空装置にセットし、5×10 -5<sub>torr</sub>の真空度でN, N'-(3-メチルフェニ ル) -1, 1' -ピフェニルー4, 4' ージアミン(T PD) を600A蒸着し、引続き8-ヒドロキシキノリ ノールアルミニウム錯体Alq $^3$ を500A蒸着した。 さらに、マグネシウム (Mg) と銀(Ag)を10:1 の原子比で2000A共蒸着し有機EL素子の構造体を 作製した。

【0104】積層体の形成

この素子の構造体を真空中 (10<sup>-4</sup>torr以下) に て、この素子の構造体上に旭化成社製、商品名:サラン ラップ(サランラップの酸素透過係数は 5.3×10 -13 cc・cm/cm² ・s・(cmHg))をかぶ せ、素子の構造体の端の部分を熱プレス(180℃、1 0秒) した。以上のように作製した素子を下記の評価条 件下にて初期輝度100cd/m² にて定電流駆動し た。

33

【0105】 [比較例7] 実施例12で用いた構造体を 10 その上に積層体を形成することなく、初期輝度100c d/m<sup>2</sup> にて定電流駆動で下記の評価条件下にて連続駆 動した。両者500時間連続駆動後、素子内の発光面積 は実施例12の場合3.95cm² に対し、比較例7の 場合2cm² であった。評価条件は25℃乾燥空気(純 度99.99%以上の酸素とチッ素の1:4の混合気 体) 中(ガラスケース内) で駆動した。その結果、実施 例12に示すように、封止することで無発光領域の発生 を抑制する効果がみられた。

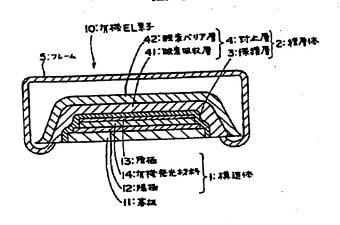
# [0106]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の第一〜第 三、及び第五の発明によれば酸素や水分による発光特性 の劣化を防止して、長期に亘って安定な発光特性を維持 することができ、長寿命の有機EL素子を提供すること ができる。また、本発明の第四の発明によれば、温度サ イクルによる素子の機械的劣化を防止して長期に亘って 安定な発光特性を維持することができ長寿命の有機EL **素子を提供することができる。さらに、第一~第五の発** 明を適宜組み合わせることによって酸素、水分、温度サ イクル等による素子の劣化を防止して、さらに品質の優 れた長寿命の有機EL素子を提供することができる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の、第一の発明の具体例を模式的に示す 断面図である。

【図1】



【図2】本発明の、第二の発明の具体例を模式的に示す 断面図である。

34

【図3】本発明の、第三の発明の具体例を模式的に示す 断面図である。

【図4】 本発明の、第四の発明の具体例を模式的に示す 断面図である。

【図5】本発明の、第五の発明の具体例を模式的に示す 断面図である。

【図6】本発明の、第五の発明の他の具体例を模式的に 示す断面図である。

【図7】本発明の、第五の発明の他の具体例を模式的に 示す断面図である。

# 【符号の説明】

1…構造体

10…有機EL素子

11…基板

12…陽極

13…陰極

14…有機発光材料

2…積層体 20

2'…保護封止層

21…酸化透過係数が1×10<sup>-12</sup> cc・cm/cm<sup>2</sup>

·s·(cmHg)の有機層

3 …保護層

3 1 …脱水剤

4 …封止剤

41…酸素吸収層

4 2…酸素バリア層

43…光または熱硬化性樹脂層

44…無機組成物

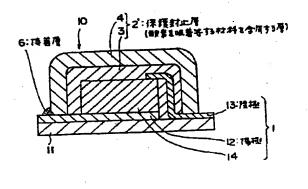
5…フレーム(ガラスまたは樹脂製)

6…接着層

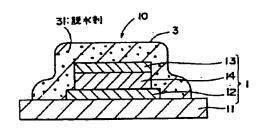
7…封止基板

8…固体ケース

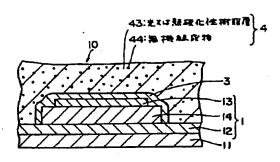
【図2】



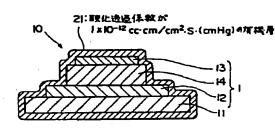
【図3】



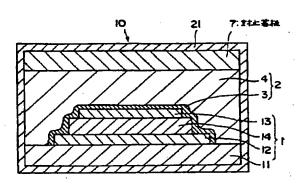
【図4】



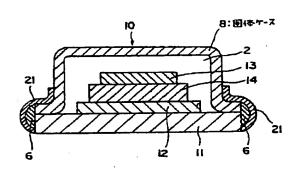
【図5】



【図6】



[図7]



# フロントページの続き

(72)発明者 中村 浩昭 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株 式会社内 (72)発明者 川村 久幸

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株 式会社内

# This Page Diank (uspto)